

平成 28 年 4 月 4 日

委員各位

日本学術振興会
結晶加工と評価技術第 145 委員会
委員長 田島 道夫

(独) 日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第 145 委員会
第 148 回研究会 開催通知

日時： 2016 年 5 月 25 日 (水) 13:00 ~ 17:30
会場： 明治大学 駿河台キャンパス グローバルフロント 1 階 多目的室
http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html
東京都千代田区神田駿河台 1-1 (TEL 03-3296-4545)
JR 中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線/御茶ノ水駅 下車徒歩 3 分
東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 下車徒歩 5 分
都営地下鉄三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線/神保町駅 下車徒歩 5 分

テーマ 「化合物半導体中の点欠陥の性質と挙動、および信頼性への影響
-ナイトライド系材料および発光デバイスを中心として-

世話人：上田 修 (金沢工業大学)、三宅秀人 (三重大学)、酒井 朗 (大阪大学)、
奥村次徳 (都立産技研)、和田一実 (MIT)

プログラム

- 13:00~13:05 開会の挨拶 明治大学 田島道夫
13:05~13:30 はじめに：発光デバイスの遅い劣化機構に関するこれまでの知見 (Ⅲ-V系)
金沢工業大学 上田 修
13:30~14:10 「パワーデバイス応用に向けたホモエピタキシャル成長 GaN 層中の深い準位の
評価」
京都大学 須田 淳、堀田昌宏
14:10~15:10 「InGaN-based LEDs and lasers: physical degradation mechanisms」
Matteo Meneghini, Univ. of Padova
15:10~15:25 休憩
15:25~16:05 「GaInN 混晶薄膜における結晶欠陥および組成変調構造」
ソニー(株) 富谷茂隆、蟹谷裕也、丹下貴志、田中伸史
16:05~16:45 「高 AlN モル分率 AlGaIn 混晶及び量子井戸における点欠陥と発光効率に関する考察」
東北大学 秩父重英、小島一信、山崎芳樹、
三重大学 三宅秀人、平松和政、筑波大学 上殿明良
16:45~17:25 「界面準位・バルク準位と GaN 接合特性との関連」
北海道大学 橋詰 保
17:25~17:30 おわりに 都立産技研 奥村次徳
17:30~17:50 総会
18:00~20:00 意見交換会(明治大学駿河台キャンパス グローバルフロント 17 階グローバルラウンジ)

以上